ETCHING TREATMENT DEVICE FOR SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

ETCHING TREATMENT DEVICE FOR SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

Patent Number:

JP1316936

Publication date:

1989-12-21

inventor(s):

YOSHIKAWA KIYOSHI; others: 01

Applicant(s):

TOSHIBA CORP

Requested Patent:

JP1316936

Application Number: JP19880149597 19880617

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/306

EC Classification:

EC Classification:

Equivalents:

JP1818443C, JP5029305B

Abstract

PURPOSE:To perform an etching treatment only on the end surface of a substrate by a method wherein an etching liquid, which is fed to a groove part of a roller, is held in the groove part by its surface tension and while the end surface is in contact with the etching liquid, the semiconductor substrate is rotated.

CONSTITUTION: A roller and a semiconductor substrate 1 are driven in such a way that they are respectively rotated in the direction oppositive to each other. An etching liquid 8, which is fed to a groove part 5' of the roller 5 through an etching liquid feeding nozzle 7, is held in the groove part 5' by its surface tension and is moved to a position to come into contact to an end surface 1' of the substrate 1 with the rotation of the roller 5 to perform an etching treatment for the end surface 1'. The feed of the etching liquid is stopped and pure water is discharged through a substrate cleaning nozzle 9 and a peripheral part cleaning nozzle 10 respectively to clean the substrate 1 and its peripheral part. The substrate 1 is rotated at high speed to perform a drying of the substrate. Thereby, an etching treatment is performed only on the end surface 1' of the substrate 1.

① 特許出題公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-316936

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)12月21日

H 01 L 21/306

J -7342-5F

審査請求 有 請求項の数 1 (全4頁)

3発明の名称 半導体基板エッチング処理装置

②特 願 昭63-149597

降

②出 願 昭63(1988)6月17日

@発明者 吉川

清 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩

川丁場内

個発明者 藤原

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝多摩

川工場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 超 曹

1. 発明の名称

半導体基板エッチング処理装置

2. 特許請求の範囲

半導体基板が水平状態となるように上記半導体基板が水平状態となるとうと、半導体基板で保持に関連を表して、上記を表して、上記を表して、上記を表して、上記を表して、大型のでは、一型を表し、一型を表し

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体基板(ウェハ)のエッチング処理装置に係り、特に基板端面のエッチング処

理に使用されるものである。

(従来の技術)

半導体基板の製造に際して、基板端面のみを エッチング処理する場合、従来は次に述べるよう に実施していた。即ち、第3回に示すように、先 ず、基板31の裏面全体に刷毛で耐エッチング液 32を塗った後、基板31と同径の弗素樹脂製の 円板33に貼り付ける。次に、この円板33が下 側になるように、基板31⇒よび円板33を熱板 上に載置し、数分間ペーキングして基板31と円 板33とを密盤させる。次に、基板31の表側 (パターン作成面) に刷毛で耐エッチング液32 を強って上記と同様にペーキングする。なお、上 記作業時には、基板端面(通常、斜面状になって いる)31に上記酎エッチング液32が付着した いよりにすることが重要である。次に、上記した よりに形成された弗素樹脂円板付き基板をピンセ ット34で挟み、エッチング液槽(ピーカー等) 35内のエッチング液36中に所要時間浸渍し、 基板端面 3 1'のみエッチング処理を行う。このよ

9なエッチング処理の後、水洗洗浄によりエッチング液を上記円板付き基板から完全に除去し、さらに、ポイル中の有機溶剤中に上記円板付き基板を受債することによって、基板3 1 と円板3 3 とを剝すと共に耐エッチング液3 2 も除去する。この後、基板を純水により洗浄し、乾燥する。

de a se

しかしたようながある。(1) 基板の選面で流に付えたける。(1) 基板の選面で流がある。(1) 基板の選面で流がある。(1) 基板の選面で流がある。(2) 基板の関面のでは、チャックででは、カックででは、カックででは、カックででは、カックででは、カックでで、カックでで、カックでは、カックでは、カッチので、カッチングを表現した。(4) 基本の対域ので、カッチの対域ので、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングでで、カッチングを表して、(5) 基板の耐エッチングを表して、(5) 基本の耐エッチングを表して、(5) 基本の耐には、(5) 基本の耐には

設けられ、回転周面に前記半導体基板の端面が非接触状態で入り込む構部を有する構付きローラと、 この講付きローラの講部に半導体基板の端面に接触してエッチングを行うためのエッチングを任 給する手段と、上記半導体基板の表面に純水を吐出して洗浄するための基板洗浄用ノズルとを具備 することを特徴とする。

(作用)

ムラが生じるので、基板の製造歩留りが低下する。 (6) エッチング液をエッチング液槽に入れ、この中で基板端面をエッチングするので、エッチング液 の使用量が多かった。(7) 耐エッチング液による被 優かよび樹脂円板の貼付け等の工程が入るので、 自動化が困難であった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、上記したような従来のエッチング処理方法における種々の問題点を解決すべくなされたもので、半導体基板の端面のみに対するエッチング処理を短時間で自動的に行うことができ、基板の製造歩留りも向上させることができ、エッチング処理装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

本発明の半導体基板エッチング処理要置は、 半導体基板が水平状態となるように上記半導体基板の片面側で保持して回転させる半導体基板保持 回転機構と、上記半導体基板の近傍で水平状態に

ペてエッチング液の使用量が少なくて済む。

(寒 施 例)

以下、図面を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。

第1図において、1は端面のエッチング処理を 必要とする半導体基板、2はこの半導体基板1が 水平状態となるように、その下面側を保持して回 転させる半導体基板保持回転機構であり、排気穴 を有すると共にモータ(図示せず)に連結された 垂直の回転軸3と、この回転軸3の上端に取り付 けられると共に上記回転軸3の排気穴と連通する 排気穴を有する真空吸着用基板チャック4とを具 備する。5は上記半導体基板1の近傍に配置され て回転され、回転周面に前記半導体基板1の端面 が非接触状態で入り込む存部 51を有すると共に水 平状態に回転自在な滞付きローラであり、6はこ のローラ5を回転させるための回転軸であり、そ の下端に上記ローラ 5 が取り付けられている。 7 は上記ローラ5の近傍に設けられ、このローラ5 の 薄部 5'に半導体基板 1 の 端面 1'に接触してエッ

at a se

ングが発生しなくなるので歩留りが大幅に向上する。(4) 常に少量の新しいエッチング液を基板端面に接触させてエッチングを行うので、エッチングムラが無くなり、歩留りが向上する。(5) 上記したエッチング処理中、人体に有害な有機溶剤に作業者が触れる機会がなくなり、作薬の安全性が向上する。

[発明の効果]

上述したように本発明の半導体基板エッチン

終了すると、エッチング液の供給を停止し、 基板 洗浄用ノベル 9 かよび周辺部洗浄用ノベル 1 0 か らそれぞれ純水を吐出させて基板 1 かよび周辺部 を洗浄する。 この後、 基板 1 を高速回転させてそ の乾燥を行り。

ク処理要量によれば、半導体基板の端面のみに対するエッチング処理を短時間で自動的に行うことができ、 基板の製造歩留りも向上させることができ、 エッチング液の使用量も少なくて済むなどの効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体基板エッチング処理 接置の一奥施例を示す構成説明図、第2図は第1 図の装置によるエッチング処理状態を示す平面図、 第3図は従来の半導体基板エッチング処理方法で 用いられる治具を示す構成説明図である。

1 … 半導体基板、1′…半導体基板の端面、2 … 半導体基板保持回転機構、3 … 回転軸、4 … 真空チャック、5 … ローラ、5′… ローラの溝部、6 … 回転軸、7 … エッチング液供給ノズル、8 … エッチング液、9 , 1 0 … 洗浄用ノズル。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





